Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук (ИППМ РАН)

Библиотека схемотехнических решений

Низкотемпературный радиационно-стойкий CJFet операционный усилитель (OУ) для задач частотной селекции

Д.В. Клейменкин, <u>k-dima-01@mail.ru</u>, А.Е. Титов, <u>alex.evgeny.titov@gmail.com</u>, Е.П. Никитина, <u>k.fialka151102@gmail.com</u>

Научно-исследовательская лаборатория проблем проектирования в экстремальной микроэлектронике ИППМ РАН и Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону)

1. Области применения CJFet OУ (рис. 1)

Предназначен для аналоговых и аналого-цифровых интерфейсов датчиков систем связи, автоматики и приборостроения, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.



Рис. 1. Функциональная схема СЈ et OУ

При этом высокая радиационная стойкость и широкий диапазон температур обеспечиваются за счет применения комплементарных полевых транзисторов с управляющим pn-переходом и оригинальной схемотехники ОУ.

Практическая реализация схемы ОУ рис. 1 может быть осуществлена в рамках CJFet техпроцесса АО «Интеграл» (г. Минск, Беларусь), а также BiCJFet АО «НПП Пульсар» (г. Москва, Россия).

2. Текстовое описание схемы рис. 1

Схема ОУ рис.1 включает:

- Входной каскад (VT1, VT2, I₁, I₂, I₃)
- Промежуточный каскад (VT3, VT4, R1);
- ПТ1 токовое зеркало;
- Выходной каскад буферный усилитель (БУ).

Статический режим ОУ рис. 1 устанавливается источниками тока, а так же резистором R1. Источники тока I₁ и I₂ могут изменяться в широких пределах (единицы микроампер – единицы миллиампер).

Цепь смещения потенциалов E_0 обеспечивает уменьшение напряжения смещения нуля ОУ за счет симметрирования статического режима по напряжению затвор-сток транзисторов VT3, VT4. Численное значение E_0 , как правило, близко к напряжению питания. В качестве E_0 могут применяться цепочки из p-n переходов, стабилитроны, а также специальные двухполюсники с низким дифференциальным сопротивлением. Во многих случаях применение E_0 не обязательно.

В качестве буферного усилителя (БУ) могут применяться более 10 вариантов CJFet схем, отличающихся друг от друга энергетическими и динамическими параметрами.

Таким образом, схема рис. 1 – это некоторая обобщенная структура ОУ в рамках CJFet технологического процесса, на которой можно реализовать десятки частных вариантов ОУ, отличающихся друг от друга схемотехникой выходного каскада (БУ), статическим режимом VT1-VT4, и, как следствие, динамическими параметрами.

В этой связи компьютерное моделирование обобщенной структурной схемы ОУ рис. 1 с идеальными источниками тока I_1 , I_2 позволяет определить предельные параметры широкого класса практических вариантов построения ОУ с архитектурой рис. 1, к которым необходимо стремиться.

3. Компьютерное моделирование ОУ рис. 1

В частном случае схема ОУ рис. 1 исследовалась в среде LTSpice на моделях библиотеки CJFET_4 (при АО «Интеграл», г. Минск, Беларусь).



Рис. 2. Графическое изображение моделей транзисторов CJFet с р-канальными (а) и п-канальными (б) транзисторами

На рис. 3 показана схема ОУ рис. 1 в среде моделирования LTSpice.



Рис. 3. Функциональная схема ОУ рис. 1 в среде LTSpise на моделях CJFet_4

4. Проходная характеристика входного каскада ОУ

Рассматриваемый ОУ построен на основе дифференциального каскада (ДК) с парафазным токовым выходом и ООС по синфазному сигналу (рис. 3). В этой связи целесообразно исследование его проходной характеристики Івых=f(Vвх).



Рис. 4. Функциональная схема входного дифференциального каскада для моделирования проходной характеристики



Рис. 5. Зависимости выходных токов Iout1, Iout2 от входного напряжения ДК рис. 4 при 27°С, сопротивлении резистора R1=1кОм, статических токах $I_1=I_2=100$ мкА, $I_3=550$ мкА, напряжениях питания V1=V2=±5B

NetList для ДК Рис. 4

* schem 001 П8841.asc V1 vcc 0 5 V2 0 vee 5 I1 vcc N002 100µ I2 vcc N003 100µ I3 N006 vee 550u J1 N002 IN1 N006 JN260_2 {JNV} J4 N006 N003 N001 JP50_2 {JPV} R1 vcc N001 1k J6 N003 OUT N006 JN260 2 {JNV} J3 N006 N002 N001 JP50 2 {JPV} J2 N004 N003 N001 JP50_2 {JPV} J5 N005 N002 N001 JP50 2 {JPV} E1 OUT 0 N004 0 1 V4 N005 vee 5 F1 N004 vee V4 1 V3 IN1 0 0 .model NJF NJF .model PJF PJF .lib C:\\LT\CJFET_4.lib .param LT=27 .param JNV=1 .param JPV=1 * .dc V3 -5 5 0.001 .op * .tran 3m * .ac dec 100 10 1G .backanno .end

5. Ожидаемые параметры и характеристики CJFet OУ

Особенностью ОУ рис. 1 является нетрадиционный метод введения отрицательной обратной связи по синфазному сигналу (ООС), позволяющий повысить дифференциальный коэффициент усиления разомкнутого ОУ. Элементы, образующие ООС и узел суммирования сигналов ООС здесь перенесены в общую истоковую цепь входного каскада.

Результаты компьютерного моделирования основных характеристик ОУ рис. 1 при температуре 27°С показаны на рис. 6, рис. 7.



Рис. 6. Зависимость систематической составляющей напряжения смещения нуля ОУ рис. 1 в диапазоне температур $-197^{0}C \div +30^{0}C$



Рис. 7. Амплитудно-частотные характеристика ОУ без ООС

Входной и выходной синусоидальные сигналы в ОУ рис. 1 со 100% отрицательной обратной связью приведены на рис. 8.



Рис. 8. Входной и выходной синусоидальные сигналы со 100% отрицательной обратной связью в ОУ рис. 1 при V_{вх}=1В

6. Параметры оптимизации

Практический интерес представляет определение оптимальных значений сопротивления резистора R1 и статических токов входного и промежуточного каскадов $I_1=2I_0+2I_0*$ и $I_2=I_3$ при заданных ограничениях на максимальную скорость нарастания выходного напряжения ОУ, разомкнутый коэффициент усиления, запас устойчивости по фазе, энергопотребление, ослабление синфазных сигналов, схемотехнику токовых зеркал и буферного усилителя и т.п.

7. Netlist для ОУ Рис. 3

* schem 001 П8841.asc V1 vcc 0 5 V2 0 vee 5 I1 vcc N002 100µ I2 vcc N003 100µ I3 N006 vee 550µ J1 N002 IN1 N006 JN260_2 {JNV} J4 N006 N003 N001 JP50_2 {JPV} R1 vcc N001 1k J6 N003 OUT N006 JN260_2 {JNV} J3 N006 N002 N001 JP50_2 {JPV} J2 N004 N003 N001 JP50_2 {JPV} J5 N005 N002 N001 JP50 2 {JPV} E1 OUT 0 N004 0 1 V4 N005 vee 5 F1 N004 vee V4 1

```
V3 IN1 0 0
.model NJF NJF
.model PJF PJF
.lib C:\\LT\CJFET_4.lib
.param LT=27
.param JNV=1
.param JPV=1
.dc V3 -5 5 0.001
.op
.tran 3m
.ac dec 100 10 1G
.backanno
.end
```

Разработка выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект 18-79-10109)

ОУ разработан на моделях CJFet_4 Дворникова Олега Владимировича.

<u>Контактная информация</u>: ОАО "Минский научно-исследовательский приборостроительный институт", Минск, Беларусь, О.В. Дворников, e-mail: <u>oleg_dvornikov@tut.by</u>